

GaN-template(GaN-заготовка)



Характеристика	Значение	
Тип проводимости	i-type	n-type
Размер пластин	2", ф50,8 мм	
Ориентация	(0001) C-ось, ±1°	
Удельное сопротивление	> 10 ⁶ Ом·см	0,5 Ом·см
Плотность дислокаций	10 ⁸ см ⁻²	
Обработка поверхности	epi-ready (готовы к эпитаксии)	
Шероховатость поверхности	1-3 нм	
Полезная поверхность	>90%	
Упаковка	Бокс под 1 подложку	
Толщина слоя	2 мкм	